

2022 年度日立ハイテク奨学生研究発表会 (No.1)

日時： 7月27日 (水) 13:30~15:45

会場： 総合研究棟 B204 室

発表者： 日立ハイテク奨学生

発表： 質疑応答含め各 10 分間

方式： ハイブリッド (オンライン参加者には Teams URL をお送りします。)

1. 13:35~13:45
スパッタ法により作製した多結晶 BaSi₂ 膜の表面ポテンシャル評価
木戸 一輝 M2 (末益都甲研)
2. 13:45~13:55
金属球を用いた SEM 検出器の特性評価
園田 涼輔 M2 (関口早田研)
3. 13:55~14:05
スパッタ法による p 型 B-doped BaSi₂ の作製と評価
長谷部 隼 M2 (末益都甲研)
4. 14:05~14:15
電子線照射によるデバイスダメージの評価
清水 凜太郎 M2 (蓮沼研)
5. 14:15~14:25
層交換多層グラフェンの膜厚変調による負極性能の考察
鈴木 大成 M2 (末益都甲研)
6. 14:40~14:50
その場観察装置と機械学習を用いた固相成長過程の自動解析
石山 隆光 M2 (末益都甲研)
7. 14:50~15:00
アルミナ碍子表面への TiN 薄膜成膜による耐電圧向上
角谷 凌太郎 M2 (伊藤研)
8. 15:00~15:10
走査電子顕微鏡における分解能評価方法の研究
戸倉 大智 M2 (関口早田研)
9. 15:10~15:20
Ga における固体、液体での反射電子強度比較
源入 健太 M2 (関口早田研)
10. 15:20~15:30
B-doped p-BaSi₂/n-Si ヘテロ接合太陽電池へのポストアニール効果
成田 隼翼 M2 (末益都甲研)